



一种具有凹坑图案的用于二次电池的电极及其制备方法和用途

专利名称: 一种具有凹坑图案的用于二次电池的电极及其制备方法和用途
专利类别: 发明
申请号: 2016111155344
第一发明人: 李叶晶
其它发明人: 王兆翔;陈立泉
专利授权日期: 2019-10-22

[关闭窗口](#)

